Project: 晶体管级电路仿真器

提交时间

5月8日(周一): 提交DC分析的网表、源码、文档

5月22日(周一): 提交瞬态分析的网表、源码、文档

6月5日(周一): 最终程序及文档提交(如需要修改)(可能会安排

presentation)

1. 项目要求

实现一个电路仿真工具,可以对包含 MOSFET、电阻器、电容器和电感器的电路执行 DC分析和瞬态分析。

为了提高非线性DC分析的收敛性,可参考第4部分的内容;为了保证瞬态仿真的准确性和提高效率,可参考第5部分的内容,动态调整时间步长。

2. MOS管模型

使用简单的MOSFET模型(即SPICE Level = 1的MOS模型的简化版,模型方程如下:

NMOS model:

Cut-off:
$$V_{gs} \leq V_T$$
,

$$I_{ds} = 0$$

$$\text{Linear:} \quad V_{gs} > V_{T} \quad \text{ and } \quad V_{ds} \leq V_{gs} - V_{T},$$

$$I_{ds} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} ((V_{gs} - V_T) V_{ds} - \frac{1}{2} V_{ds}^2)$$

Saturation: $V_{gs} > V_T$ and $V_{ds} > V_{gs} - V_T$,

$$I_{ds} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{ds})$$

PMOS model:

Cut-off:
$$V_{sg} \leq -V_T$$
,

$$I_{sd} = 0$$

Linear:
$$V_{sg} > -V_T$$
 and $V_{sd} \le V_{sg} - (-V_T)$,

$$I_{sd} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} ((V_{sg} - (-V_T))V_{sd} - \frac{1}{2}V_{sd}^2)$$

Saturation: $V_{sg} > -V_T$ and $V_{sd} > V_{sg} - (-V_T)$,

$$I_{sd} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{sg} - (-V_T))^2 (1 + \lambda V_{sd})$$

提示: MOSFET的源端和漏端不是固定的,需要由两个端口当前的电压值来判断。

寄生电容模型:

简化起见,我们忽略MOS管模型中寄生电容的非线性特性,假定各寄生电容形式如下:

Gate-source capacitance:

$$C_{gs} = \frac{1}{2} C_{ox} WL$$

Gate-drain capacitance:

$$C_{gd} = \frac{1}{2} C_{ox} WL$$

Source/drain to ground junction capacitance:

$$C_{\scriptscriptstyle d}=C_{\scriptscriptstyle s}=C_{\scriptscriptstyle j0}$$

在网表中, MOSFET用以下语句调用(大小写不敏感):

Mxxx <ND> <NG> <NS> <MODEL ID> <WIDTH> <LENGTH>

在网表文件中, MOS管的模型用以下.MODEL开头的语句定义(大小写不敏感):

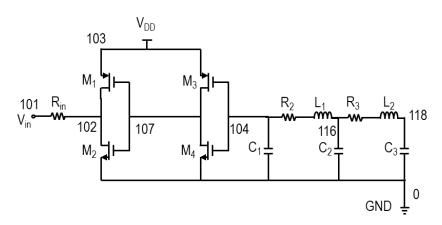
.MODEL <MODEL ID> VT <V_T> MU < μ > COX <Cox> LAMBDA < λ > CJ0 <CJ0>

其中 V_T 是阈值电压的值, μ 是迁移率的值, λ 是沟道宽度调制系数的值, C_{J0} 是结电容的值。上述语句表示若采用类型为<MODEL_ID>的晶体管,则定义阈值电压 $VT=V_T$,迁移率 $MU=\mu$, $COX=C_{OX}$,沟道宽度调制系数 LAMBDA = λ ,结电容 $CJO=C_{J0}$ 。晶体管的类型由<MODEL_ID>的第一个字母决定,P开头表示晶体管模型为PMOS(大小写不敏感),N开头表示晶体管模型为PMOS(大小写不敏感)。其他网表格式可参考 SPICE手册。

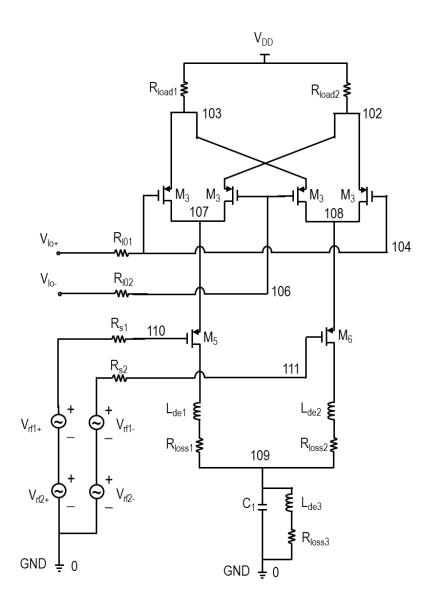
3.测试电路

我们有两个测试电路来验证仿真器的功能,如下所示:

1. non-inverting buffer (buffer.sp)



2. double balanced mixer (dbmixer.sp)



除此之外:

- (1) 必须自行设计一个简单的inverter,同样可以采用程序完成DC和瞬态分析。
- (2) 可以额外增加选取其他电路进行仿真。我们会根据你选取的电路的性能(如规模、 仿真成本等)给予加分。

4. 瞬态仿真的初值设定

在对非线性电路进行瞬态仿真之前,我们一般需要在 t=0 的时候先进行DC仿真。但是,DC仿真需要一个较好的初始点,不合理的初始值设置很容易导致DC仿真失败。这里

列出了三种常见的解决方法。按实用性排列,越往后的方案越实用,因此建议尝试第三个方案。也欢迎同学们查找相关文献,寻求收敛性更好、成本更低的方案。我们会根据具体实现的创新性和实用性进行加分。但是不论采用何种方法,必须保证仿真结果的正确性。例如inverter基准电路的仿真结果都应该是上升沿输入,下降沿输出(或者反过来)。

- 1. 手工进行直流分析,将L和C的初始电流和电压设置为人工分析得到的直流解,直接做瞬态分析。注意:采用这一方案,t=0处的解不是通过程序进行DC分析得到,而是手工分析得到的。
- 2. 将L和C的初始电流和电压设置为一个较为合理的猜测的值,然后进行直流分析,得到 DC解,再用这一DC的解作为 t=0 时刻的瞬态解。相对前一方案,本方案所需的人工成本较少。
- 3. 将直流分析的电源视为具有较长上升时间的斜坡输入信号,将所有节点电压初始化为零,然后进行一次瞬态分析。使用本次瞬态分析结束时刻(即 $t = t_{stop}$ 处)的解作为实际瞬态分析t = 0时刻的解,开始进行真正的瞬态分析。这种方法是对"打开"电源(即power on)这一过程的模拟,适用于大多数电路。注意:本方案需要进行一次额外的瞬态分析,得到t = 0时刻的解。

5. 时间步长的动态调整

在瞬态仿真中,固定时间步长在某些情况下可能会导致较大的局部截断误差,还有可能会会导致非线性牛顿迭代算法出现收敛问题。如果检测到不收敛,必须以较小的时间步长重新仿真电路,以实现收敛。因此,建议对时间步长进行动态调整。

为了估计时间步长,可能需要计算电容电压和电感电流的二阶导数(可以使用之前时间点的解来近似这些导数)。也欢迎同学们查找相关文献,开发自己的方法来动态控制时间步长。我们会根据具体实现的创新性和实用性进行加分。

为了评估动态时间步长调整方案的效率,建议对固定时间步长和动态时间步长的仿真 结果进行比较。

6. 其他说明

- 1. 程序可以采用matlab、python、C/C++实现;
- 2. 不同的仿真所采用的网表有可能不同(主要体现在输入激励和输出的测试语句),参 考HSPICE手册,基于给定的网表进行修改,以满足不同的仿真要求。

- 3. 建议在仿真结束后,绘制输出仿真波形(根据网表中的.probe语句指定所需画图的信号,一般是输出端的电压或者电流)。
- 4. 有兴趣可自行完成AC分析及稳态分析程序,本项目中提供的两个电路同样可以作为 AC分析及稳态分析的测试电路。
- 5. 提交文件包括:
 - a) 测试网表及网表说明文档,包括对网表中特定语句的说明。建议尽量参考SPICE常规格式,有修改或者不同之处一定要加以说明;
 - b) 源码,注意要进行仿真一定要根据网表建立方程。所以建立方程的源码和线性求解器的源码也需要提交;
 - c) 实验报告(pdf或者word格式),包括以下内容:
 - i. 程序说明文档(包括:输入输出及程序调用方法;类、函数等程序结构设计等):
 - ii. 处理初值问题、时间步长控制等的具体实现方案;
 - iii. 自己构建的测试电路的电路图;
 - iv. 每个测试电路利用仿真程序得到的仿真波形及对仿真结果的分析(如第5部分中提到的固定时间步长和动态时间步长的仿真结果的比较等,以证明程序的正确性和效率),要求清晰可读性好。
 - v. 与仿真程序相关的其他创新性说明(要完成了具体的程序实现)
 - vi. 较为完整的文献及引用